14482, Москва, Зеленоград, а/я 167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 229-75-27, тел.(495) 229-75-28. E-mail: epl@epl.ru, http://www.epl.ru

# **КТД 8281 (А,Б,В)** Мощный PNP кремниевый транзистор АДКБ.432140.167ТУ

**КТД8281** - биполярный эпитаксиально-планарный транзистор Дарлингтона с защитным встроенным диодом.

## Прибор предназначен для применения

в схемах управления двигателями, низковольтовых DC/DC и DC/AC преобразователях, источниках бесперебойного питания и источниках лазерной накачки.

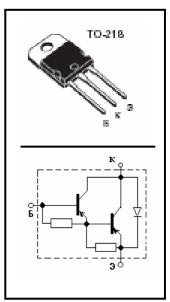
#### Отличительные особенности:

комплиментарная пара(к КТД8280) на токи коллектора 25-60А с низким напряжением насыщения.

Аналог: нет.

## Выпускается:

в пластмассовом корпусе ТО-218 и в бескорпусном исполнении - кристалле для использования в составе гибридных схем.



### Предельно-допустимые режимы эксплуатации.

Параметры	Обозначение	КТД8281			Ед.
Параметры	Обозначение	A	Б	В	измер.
Напряжение коллектор-база	Uкбо	80	100	120	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэo	80	100	120	В
Напряжение эмиттер-база	Uэбо	5	5	5	В
Ток коллектора постоянный	lκ	60	60	60	A
Ток коллектора импульсный	Іки	80	80	80	A
Ток базы постоянный	Іб	5	5	5	A
Рассеиваемая мощность коллектора	Рк тах	120	120	120	Вт
Температура перехода	Ti Ti	-65÷+150	-65÷+150	-65÷+150	°C

#### Основные электрические параметры (Ткорп.=25 °C).

	Обозна		D	Групп	Ед.
Параметры	чение	Норма	Режим	á	изм
Обратный ток коллектор-эмиттер	Ікэо	≤150	Uкэ=60B, R <sub>Б</sub> =∞	Α	
			Uкэ=80B, R <sub>Б</sub> =∞	Б	мкА
			Uкэ=100B, R <sub>Б</sub> =∞	В	
Обратный ток коллектор-база	Ікбо	≤100	Uкб= Uкэо <sub>ГР</sub> +20В	А,Б,В	мкА
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	<b>Икэо</b> гР	≥80		Α	
		≥100	Iк=100мA	Б	В
		≥120		В	
Обратный ток эмиттер-база	Іэбо	≤20	Uэб=5	А,Б,В	мА
Напряжение насыщения коллектор-	Uкэ нас	≤1,5	IK=30A, Iб=50MA	А,Б,В	В
эмиттер	ONO Had			71,0,0	
Напряжение насыщения	<b>Обэ</b> нас	≤2,5	Iк=30A, Iб=50мA	А,Б,В	В
база -эмиттер	233 1140	<u></u>	11007 ij 10-00W/ t	, ., .	
Статический коэффициент передачи тока	h <sub>219</sub>	≥1000	Ік=50А,	А,Б,В	-